

Si - Sb

1964

69M

$\text{HC}(\text{SiH}_3)_3$, $\text{P}(\text{SiH}_3)_3$, $\text{As}(\text{SiH}_3)_3$,

$\text{Sb}(\text{SiH}_3)_3$ (Tb, p, Δ Hv)

Amberger E., Boeters H.D.
Chem.Ber., 1964, 97, N 7,
1999-2004

Trisilylverbindungen.

Be

Si_3SbH_9

$SV(SiH_3)_3$ (м)
(р, Тв, ΔVH)

1971
2789-IV-ТКВ

Соколов В.Б.

Давление пара, температура кипения и энтальпия испарения трисилилфосфина, трисилиларсина и трисилилстибина, 5 с.

SbSi

(T_2)

1978

11 E632. Двупреломление и фазовые переходы в SbSi. Inushima Takashi, Uchinokura Kunimitsu, Matsuura Etsuyuki. Birefringence and phase transitions in SbSi. «J. Phys. Soc. Jap.», 1978, 44, № 5, 1656—1663 (англ.)

Измерено двупреломление (δn) в монокристаллах SbSi в температурном интервале, включающем точки фазовых переходов первого ($T_1 = 15,7^\circ \text{C}$) и второго родов ($T_2 = -36,6^\circ \text{C}$). Установлено, что в окрестности T_2 температурная зависимость δn определяется соотношением $\delta n(T) = A[(T - T_2)/T_2]^{2\beta}$, где $\beta = 0,51$ при $T < T_2$ и $\beta = 0,53$ при $T > T_2$. Вблизи T_1 β зависит от $\varepsilon = T - T_1/T_1$: при $\varepsilon > 5 \cdot 10^{-3}$ $\beta = 0,38$, а при $\varepsilon < 5 \cdot 10^{-3}$ $\beta = 0,53$. И. Р.

ф; 1978, N 11

SbSi

1979

$\text{NaNH}_4\text{SO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

CsCdCl_3

10 E867. Комплексные исследования фазовых переходов под давлением. Серебренников В. Л., Александрова И. П. «Ин-т физ. Сиб. отд. АН СССР. Препр.», 1979, № 98, 77с., ил.

Описаны комплекс аппаратуры высокого давления и результаты выполненных с его помощью исследований фазовых превращений в LiNH_4SO_4 , CsCdCl_3 , $\text{NaNH}_4\text{SeO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, SbSi , кристаллах семейства триглицинсульфата и др. при высоких давлениях. Библ. 65.

фазов.
переход.

(+2) 17

Ф.1979/10

SbSi

1983

7 E367. Теплоемкость SbSi. Specific heat of SbSi. Rosar M. E., Smith W. A., Bhalla A. «J. Phys. and Chem. Solids», 1983, 44, № 2, 117—118 (англ.)

Теплоемкость монокристаллов SbSi измерена в интервале t -р 230—500 К с помощью сканирующего дифференциального калориметра. Определена энтропия сегнетоэлектрического перехода. Результаты, полученные для образцов, отличающихся разной технологией приготовления, оказались различными, что связано с различием примесей кислорода.

$C_p, \text{ Дж/моль}^\circ\text{К}$

Ф. 1983, 18, N 7.

Si - Sb

1985

/ 106: 163245e The antimony-silicon system. Olesinski, R. W.; Abbaschian, G. J. (Dep. Mater. Sci. Eng., Univ. Florida, Gainesville, FL 32611 USA). *Bull. Alloy Phase Diagrams* 1985, 6(5), 445-8, 501-2 (Eng). The assessed equil. phase diagram for the Si-Sb system is presented. The heat and entropy of mixing in the liq. state are known. Sb forms substitutional solid solns. in Si. The lattice parameters were calcd. as functions of Si concn. (10^{18} atoms/cm³ soln.).

фазовая
диаграмма

C. A. 1987, 106, N 20.

SbSi_x

Im 29760

1988

22 БЗ127. Термодинамические свойства расплавов систем Si—(Mg, Sb). Судавцова В. С., [Баталин Г. И.], Зеленина Л. Н. «Укр. хим. ж.», 1988, 54, № 6, 655—657

Методом калориметрии определены энтальпии образования жидк. расплавов двойных систем Si—(Mg, Sb) при 1132 и 1535 К соотв. Установлено, что при 1132 К граница р-имости соответствует $X_{Si}=0,08$. Полученные парц. и интегральные энтальпии смешения расплавов системы Mg—Si удовлетворительно согласуются с лит. Для жидк. сплавов системы Sb—Si $\Delta H = 7$ кДж/моль при $X_{Si}=0,2$. Все термодинамич. св-ва изученных расплавов системы Sb—Si выражены положительт. величинами.

Автореферат

(ΔH)

X.1988, N 22.

1997

F: SbSi

P: 1

ЗБ250. Фазовая диаграмма SbSi и кристаллическая структура антисегнетоэлектрической фазы. Phase diagram of SbSi and crystal structure of the antiferroelectric phase / Lukaszewicz K., Pietraszko A., Stepien-Damm J. // ECM-17: 17th Eur. Crystallogr. Meet., Lisboa, 24-28 Aug., 1997: Programme and Book Abstr. - Lisboa, 1997. - С. 1-10. - Англ.
